

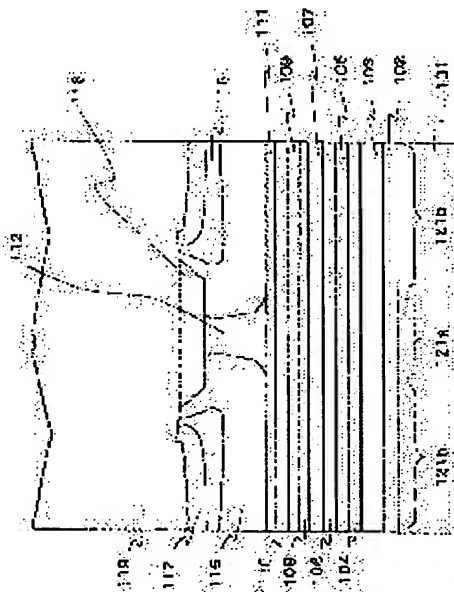
(11)Publication number : 2004-296635
(43)Date of publication of application : 21.10.2004

H01S 5/343
G11B 7/125
H01L 21/205

(72)Inventor: HIRUKAWA SHUICHI
KASAI SHUSUKE
YAMAMOTO KEI

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor laser exhibiting high reliability and long lifetime under high output driving state, and to provide an optical disc drive employing it.

SOLUTION: In the semiconductor laser having an oscillation wavelength of 760–800 nm, n-type first and second lower clad layers 103 and 104, a lower guide layer 105, a GaAs lower interface protective layer 106, an InGaAsP strained multiple quantum well active layer 107, a GaAs upper interface protective layer 108, an upper guide layer 109, and a p-type upper clad layer 110 are formed sequentially on an n-type GaAs substrate 101. The interface becomes steep between the quantum well active layer 107 and the upper guide layer 109 and between the quantum well active layer 107 and the lower guide layer 105 and epitaxial growth is improved.



[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

<http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA6HaiUTDA416296635...> 2005/06/14

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) **公開特許公報(A)**

(11) 特許出願公開番号

特開2004-296635

(P2004-296635A)

(43) 公開日 平成16年10月21日(2004.10.21)

(51) Int.Cl.⁷

HO 1 S 5/343

G 1 1 B 7/125

H O 1 L 21/205

F I

HO 1 S 5/343

G 1 1 B 7/125

HO 1 L 21/205

テーマコード (参考)

5 D 7 8 9

5 F 0 4 5

5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2003-85112 (P2003-85112)

(22) 出願日 平成15年3月26日 (2003. 3. 26)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(74) 代理人 100062144

奔理士 青山 葆

(74) 代理人 100086405

弁理士 河宮 治

(74) 代理人 100084146

弁理士 山崎 宏

(72) 発明者 蛭川 秀一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

(72) 發明者 河西 秀典

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

最終頁に続く

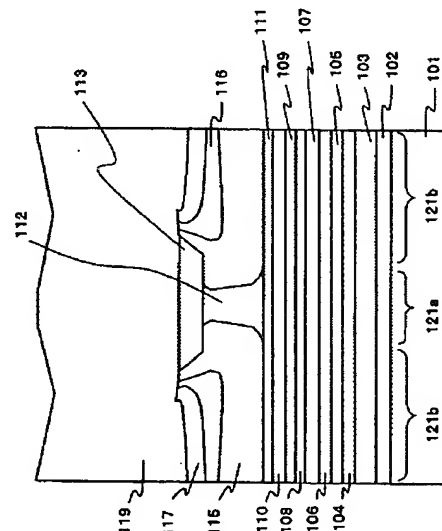
(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置およびその製造方法および光ディスク装置

(57)【要約】

【課題】高出力駆動状態において信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置およびそれを用いた光ディスク装置を提供する。

【解決手段】発振波長が760nmより大きく800nmより小さい半導体レーザ装置であって、n型のGaAs基板101上に、n型の第1、第2下クラッド層103、104、下ガイド層105、GaAs下界面保護層106、InGaAsP多重歪量子井戸活性層107、GaAs上界面保護層108、上ガイド層109、p型の上クラッド層110を順次積層する。上記量子井戸活性層107と上ガイド層109との間および量子井戸活性層107と下ガイド層105との間の界面が急峻になるとともに、結晶のエピタキシー成長が良好になる。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

GaAs 基板上に、下ガイド層、InGaAsP からなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、上ガイド層が少なくとも積層されている半導体レーザ装置において、
発振波長が760nmより大きく800nmより小さく、上記量子井戸活性層と上記上ガイド層との間または上記量子井戸活性層と上記下ガイド層との間の少なくとも一方に界面保護層が設けられていることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の半導体レーザ装置において、
上記界面保護層がGaAs からなることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の半導体レーザ装置において、
上記界面保護層の層厚が30Å以内であることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の半導体レーザ装置において、
上記上ガイド層および上記下ガイド層がAlGaAs からなることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の半導体レーザ装置において、
上記上ガイド層および上記下ガイド層のAl 混晶比が0.2より大きいことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 つに記載の半導体レーザ装置において、
上記井戸層が圧縮歪を有することを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の半導体レーザ装置において、
上記圧縮歪の量が3.5%以内であることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 つに記載の半導体レーザ装置において、
上記バリア層が引張歪を有することを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の半導体レーザ装置において、
上記引張歪の量が3.5%以内であることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 10】

GaAs 基板上に、少なくともAlGaAs からなる下ガイド層、InGaAsP からなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、AlGaAs からなる上ガイド層を有する半導体レーザ装置の製造方法において、
第1の成長温度にて上記下ガイド層およびGaAs からなる下界面保護層を結晶成長させる第1の工程と、

上記第1の工程の後、成長を中断し第2の成長温度まで成長温度を下降させる第2の工程と、

上記第2の工程の後、成長を再開して上記量子井戸活性層とGaAs からなる上界面保護層とを順次成長させる第3の工程と、

上記第3の工程の後、成長を中断し成長温度をほぼ上記第1の成長温度まで上昇させる第4の工程と、

上記第4の工程の後、成長を再開して上記界面保護層上に上記上ガイド層を成長させる第5の工程と、を含むことを特徴とする半導体レーザ装置の製造方法。

【請求項 11】

請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 つに記載の半導体レーザ装置を用いていることを特徴とする

光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体レーザ装置および光ディスク装置に関するものであり、特に高出力・高信頼性を実現できる半導体レーザ装置およびそれを用いた光ディスク装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

半導体レーザ装置は光通信装置や光記録装置などに用いられるが、近年、その高速化・大容量化といったニーズが高まってきており、それに応えるために半導体レーザ装置の様々な特性を向上させるための研究開発が進められている。

【0003】

その中で、従来CDやCD-R/RWといった光ディスク装置に用いられる780nm帯の半導体レーザ装置は、AlGaAs系の材料により作製されている。CD-R/RWにおいても高速書き込みに対する要求は益々高まってきているため、これに対応するために半導体レーザ装置の高出力化が要求されている。

【0004】

従来のAlGaAs系半導体レーザ装置としては、図12に示すものがある（例えば、特許文献1参照）。このAlGaAs系半導体レーザ装置の構造を簡単に説明する。図12に示すように、n-GaAs基板501上に、n-GaAsバッファ層502、n-Al_{0.3}Ga_{0.7}As下クラッド層503、Al_{0.3}Ga_{0.7}As下ガイド層504、Al_{0.3}Ga_{0.7}As井戸層（層厚80Å、2層）とAl_{0.3}Ga_{0.7}As障壁層（層厚50Å、3層）を交互に配置してなる多重量子井戸活性層505、Al_{0.3}Ga_{0.7}As上ガイド層506、p-Al_{0.3}Ga_{0.7}As第1上クラッド層507、p-GaAsエッチストップ層508が順次積層されており、さらに上記エッチストップ層508上に、メサストライプ状のp-Al_{0.3}Ga_{0.7}As第2上クラッド層509、その上部に庇状のp-GaAsキャップ層510が形成されている。また、上記第2上クラッド層509両側には、n-Al_{0.3}Ga_{0.7}As第1電流ブロック層511およびn-GaAs第2電流ブロック層512が積層されて、上記メサストライプ以外の領域が電流狭窄部となっている。また、上記第2電流ブロック層513上にp-GaAs平坦化層513が設けられ、更に全面にp-GaAsコンタクト層514が積層されている。

【0005】

この半導体レーザ装置のしきい値電流はおよそ35mAであり、COD（光学損傷：Catastrophic Optical Damage）レベルがおよそ160mW程度となっている。

【0006】

【特許文献1】

特開平11-274644号公報（段落0053、図1）

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記AlGaAs系の材料を用いた半導体レーザ装置では、活性なAlの影響により、高出力駆動時にレーザ光出射端面においてCOD（光学損傷）による端面破壊が起こりやすく、最高光出力も160mW程度でしかなかった。このCODによる端面破壊は、以下のようなメカニズムによって生じていると考えられている。共振器端面においては、Alが容易に酸化されるためにそれにより表面準位が形成される。活性層に注入されたキャリアはこの準位を介して緩和し、そのときに熱を放出するため、局所的に温度が上昇する。この温度上昇によって端面近傍の活性層のバンドギャップが縮小し、レーザ光が端面近傍の活性層で吸収され発生したキャリアが、また表面準位を介して緩和し発熱

する。このような正帰還を繰り返すことにより最終的に端面が溶融して発振停止に至ると考えられている。従来の半導体レーザ装置では、活性領域にAlが含まれているため、端面破壊が大きな問題となる。

【0008】

そこで、本発明者は、活性領域にAlを含まない(Alフリー)材料であるInGaAsP系による高出力半導体レーザ装置の研究を進めている。もともとこのAlを含まない材料系は、同じバンドギャップのエネルギー(E_g)であっても、コンダクションバンド(伝導帯)下端のエネルギー準位(E_c)とバレンスバンド(価電子帯)上端のエネルギー準位(E_v)の値が変わってくる。特に格子定数がGaAs基板に近い組成の場合、 E_g はバレンスバンド側に広がってくる。よって、井戸層およびバリア層にInGaAsP系はAlGaAs系の半導体レーザ装置ほどに大きさを確保できない。そのため、井戸層およびバリア層からなる活性領域の外側には、十分な ΔE_c を確保し、電子のオーバーフローを防げるように、AlGaAs系の材料の層が必要となるが、量子井戸活性層との材料系の違いに起因すると考えられる結晶の劣化を抑える必要もある。

【0009】

そこで、本発明の目的は、高出力駆動状態において信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置およびその半導体レーザ装置を用いた光ディスク装置を提供しようとするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明に係る半導体レーザ装置は、GaAs基板上に、下ガイド層、InGaAsPからなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、上ガイド層が少なくとも積層されている半導体レーザ装置において、発振波長が760nmより大きく800nmより小さく、上記量子井戸活性層と上記上ガイド層との間、または上記量子井戸活性層と上記下ガイド層との間の少なくとも一方に界面保護層が設けられていることにより、上記量子井戸活性層と上記上ガイド層あるいは上記下ガイド層もしくはその両方の界面が急峻になるとともに、結晶のエピタキシー成長が良好になるため、GaAs基板上の高出力半導体レーザ装置(特にCD-R/RW用780nm帯高出力半導体レーザ装置)の高出力駆動時において信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を実現することができる。

【0011】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記界面保護層がGaAsからなることにより、上記GaAs基板上に安定した薄い半導体層を積層することができ、良好に切り替わる界面を作成できるので、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を得ることができる。

【0012】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記界面保護層の層厚が30Å以内であることにより、760nmより大きく800nmより小さい発振波長のレーザ光を吸収しにくいため、半導体レーザ装置の特性を損ねることなく、良好に切り替わる界面を作成できるので、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を得ることができる。

【0013】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記上ガイド層および下ガイド層がAlGaAsからなることにより、発光再結合のおこる井戸層にAlGaAsを隣接させないことで信頼性を確保しながら、キャリアのオーバーフローはAlGaAsのコンダクションバンド(伝導帯)下端のエネルギー準位(E_c)、バレンスバンド(価電子帯)上端のエネルギー準位(E_v)により十分に抑制できるので、信頼性が高く長寿命な高出力半導体レーザ装置が実現できる効果がある。また、上記界面保護層が上記量子井戸活性層と上記ガイド層との間にあり、上記ガイド層内を構成するAlGaAsと上記量子井戸活性層とを接しないようにすることができ、より上記井戸層とAlGaAsの距離を保てるので、上記と同様

の効果を得ることができる。

【0014】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記上ガイド層および下ガイド層を構成するAlGaAsのAl混晶比が0.2より大きいことから、より好適に上記効果が得られる。

【0015】

一実施形態の半導体レーザ装置は、GaAs基板上のInGaAsPからなる圧縮歪を有する量子井戸活性層が用いられているために発振しきい値電流が低減され、これにより特に780nm帯において信頼性が高く長寿命な高出力半導体レーザ装置が実現できる効果がある。

【0016】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記圧縮歪量が3.5%以内であることにより、より好適に上記効果が得られる。

【0017】

一実施形態の半導体レーザ装置は、InGaAsPからなる引張歪を有する障壁層が用いられており、圧縮歪を有する井戸層に対してその歪量を補償しているため、より安定した結晶をもつ歪量子井戸活性層を作製することができ、高信頼性の半導体レーザ装置が実現できる効果がある。

【0018】

一実施形態の半導体レーザ装置は、上記引張歪量が3.5%以内であることにより、より好適に上記効果が得られる。

【0019】

また、本発明に係る半導体レーザ装置の製造方法は、GaAs基板上に、少なくともAlGaAsからなる下ガイド層、GaAsからなる下界面保護層、InGaAsPからなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、GaAsからなる上界面保護層、AlGaAsからなる上ガイド層を有する半導体レーザ装置の製造方法において、第1の成長温度にて上記下ガイド層およびGaAsからなる下界面保護層を結晶成長させる第1の工程と、上記第1の工程の後、成長を中断し第2の成長温度まで成長温度を下降させる第2の工程と、上記第2の工程の後、成長を再開して上記量子井戸活性層とGaAsからなる上界面保護層とを順次成長させる第3の工程と、上記第3の工程の後、成長を中断し成長温度をほぼ上記第1の成長温度まで上昇させる第4の工程と、上記第4の工程の後、成長を再開して上記界面保護層上に上記上ガイド層を成長させる第5の工程と、を含むことにより、上記下ガイド層のAlGaAsの酸化を上記下界面保護層が防いで、上記下ガイド層よりも成長温度の低い上記量子井戸活性層を成長させることができ、また、上記量子井戸活性層内の昇温によるPの再蒸発を上記上界面保護層が防いで、上記上ガイド層を成長させることができ、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を製造することができる。

【0020】

また、本発明に係る光ディスク装置は、本発明に記載の半導体レーザ装置を用いており、光ディスク装置に対して、従来よりも高い光出力で動作する半導体レーザ装置であるため、ディスクの回転数を従来より高速化してもデータの読み書きが可能である。従って、特に書き込み時に問題となっていたディスクへのアクセス時間が従来の半導体レーザ装置を用いた装置よりも格段に短くなり、より快適に操作できる光ディスク装置を提供できる効果がある。

【0021】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の半導体レーザ装置およびその製造方法および光ディスク装置を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【0022】

(第1実施形態)

図1は、本発明に係る半導体レーザ装置の構造の一例を示したものである。この半導体レ

10

20

30

40

50

ーザ装置の構造は、半導体基板表面にバッファ層・第1導電型半導体下クラッド層・量子井戸活性層・第2導電型半導体上クラッド層が積層され、上記上クラッド層の一部までがメサストライプ形状を有し、上記ストライプ両側を第1・第2導電型半導体電流ブロック層によって埋め込まれている。

【0023】

図1に示すように、 n -GaAs基板101上に、 n -GaAsバッファ層102、 n -AlGaAs第1下クラッド層103、 n -AlGaAs第2下クラッド層104、AlGaAs下ガイド層105、GaAs下界面保護層106、多重歪量子井戸活性層107、GaAs上界面保護層108、AlGaAs上ガイド層109、 p -AlGaAs第1上クラッド層110および p -GaAsエッチングストップ層111を順次積層している。このエッチングストップ層111上に、メサストライプ形状の p -AlGaAs第2上クラッド層112およびGaAsキャップ層113を設けると共に、上記メサストライプ形状の p -AlGaAs第2上クラッド層112およびGaAsキャップ層113の両側を、 n -AlGaAs第1電流ブロック層115、 n -GaAs第2電流ブロック層116および p -GaAs平坦化層117からなる光・電流狭窄領域で埋め込み、さらに、全面に p -GaAsキャップ層119を設けている。この半導体レーザ装置は、メサストライプ部121aと、そのメサストライプ部121aの両側方のメサストライプ部側方部121bとを有する。

【0024】

次に図2～図4を参照しながら、上記半導体レーザ構造の作製方法を説明する。図2に示すように、(100)面を持つ n -GaAs基板101上に、 n -GaAsバッファ層102(層厚0.5 μ m)、 n -Al_{0.466}Ga_{0.534}As第1下クラッド層103(層厚3.0 μ m)、 n -Al_{0.498}Ga_{0.502}As第2下クラッド層104(層厚0.18 μ m)、Al_{0.433}Ga_{0.567}As下ガイド層105(層厚70nm)、GaAs下界面保護層106(層厚10Å)、In_{0.2111}Ga_{0.7889}As_{0.6053}P_{0.3947}圧縮歪量子井戸層(歪0.12%、層厚80Å、2層)とIn_{0.0932}Ga_{0.9068}As_{0.4071}P_{0.5929}バリア層(歪1.44%、基板側から層厚70Å・50Å・70Åの3層)を交互に配置してなる多重歪量子井戸活性層107、GaAs上界面保護層108(層厚10Å)、Al_{0.433}Ga_{0.567}As上ガイド層109(層厚70nm)、 p -Al_{0.4885}Ga_{0.5115}As第1上クラッド層110(層厚0.19 μ m)、 p -GaAsエッチングストップ層111(層厚30Å)、 p -Al_{0.4885}Ga_{0.5115}As第2上クラッド層112(層厚1.28 μ m)、GaAsキャップ層113(層厚0.75 μ m)を順次有機金属化学気相成長法にて結晶成長させる。

【0025】

また、上記有機金属化学気相成長法による成長温度は、図10の成長温度プロファイルに示すように、上記バッファ層102から上記下界面保護層106までが750℃である。そして成長を中断し680℃まで降温させてから、上記量子井戸活性層107から上記上界面保護層108までを順次積層する。その後再び成長を中断し750℃まで昇温させてから、上記上ガイド層109から上記キャップ層113までを順次積層する。

【0026】

ここで、本発明の半導体レーザ装置の製造方法の各工程に対応するのは、第1の成長温度750℃にて下ガイド層およびGaAsからなる下界面保護層を結晶成長させる第1の工程と、上記第1の工程の後、成長を中断し第2の成長温度680℃まで成長温度を下降させる第2の工程と、上記第2の工程の後、成長を再開して上記量子井戸活性層107とGaAsからなる上界面保護層108とを順次成長させる第3の工程と、上記第3の工程の後、成長を中断し成長温度を第1の成長温度750℃まで上昇させる第4の工程と、上記第4の工程の後、成長を再開して上界面保護層108上に上ガイド層109を成長させる第5の工程である。

【0027】

さらに、図2において、メサストライプ部を形成する部分に、レジストマスク114（マスク幅 $5.5\mu\text{m}$ ）をストライプ方向が（011）方向を持つように写真工程により作製する。

【0028】

次に、図4に示すように、上記レジストマスク114（図2に示す）以外の部分をエッチングし、メサストライプ部121aを形成する。このエッチングは、硫酸と過酸化水素水の混合水溶液およびフッ酸を用いて二段階で行い、エッチングストップ層111直上まで行う。GaAsはフッ酸によるエッチングレートが非常に遅いということを利用し、エッチング面の平坦化およびメサストライプの幅制御を可能にしている。また、エッチングの深さは $1.95\mu\text{m}$ 、メサストライプの最下部の幅は約 $2.5\mu\text{m}$ である。エッチング後、上記レジストマスク114を除去する。 10

【0029】

続いて、図4に示すように、 $n\text{-Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{As}$ 第1電流ブロック層115（層厚 $1.0\mu\text{m}$ ）、 $n\text{-GaAs}$ 第2電流ブロック層116（層厚 $0.3\mu\text{m}$ ）、 $p\text{-GaAs}$ 平坦化層117（層厚 $0.65\mu\text{m}$ ）を順次有機金属結晶成長させ、光・電流狭窄領域を形成する。

【0030】

その後、図3に示すように、写真工程により、上記メサストライプ部両側121b上のみレジストマスク118を形成する。続いて、上記メサストライプ部121a上のブロック層をエッチングにより除去する。このエッチングには、アンモニアと過酸化水素水の混合水溶液および硫酸と過酸化水素水の混合水溶液を用いて、二段階でエッチングを行う。 20

【0031】

その後、上記レジストマスク118を除去し、図1に示す $p\text{-GaAs}$ キャップ層119（層厚 $2.0\mu\text{m}$ ）を積層する。このようにして、図1に示す構造の半導体レーザー装置を作製することができる。

【0032】

本第1実施形態において、発振波長は 780nm であり、図6に示すように、光出力ー電流特性の試験においてCODレベルが 300mW 以上で安定な動作を確認すると共に、図7に示すように、 70°C 、 230mW パルスの信頼性試験において 5000 時間以上の安定な動作を確認した。このようにして本発明者は、GaAs基板上にてInGaAsP系の量子井戸活性層を用いた半導体レーザー装置の研究を進め、AlGaAs系に比べCODレベルの高い半導体レーザー装置を作製することができた。また、今回更に高出力駆動時の半導体レーザー装置の寿命や信頼性を向上すべく、ガイド層にAlGaAsを用い、かつバリア層のInGaAsPの界面において、それぞれの成長温度の違いから成長の中断に起因すると考えられる界面の結晶性の悪化による長期劣化に対して、界面保護層を設けることにより特性の向上を実現した。詳しくは、本第1実施形態のように、上記下AlGaAsガイド層および上記GaAs下界面保護層を積層した後に成長中断し、成長温度を下げ、成長再開後は上記GaAs下界面保護層上にバリア層を積層し、先述の界面の影響がバリア層とは解離されるために、特性の向上につながったと考えられる。また、上記GaAs上界面保護層をバリア層と上ガイド層の間に設けることも、同様に特性の向上につながったと考えられる。なお、図7において I_{op} とは、 70°C における半導体レーザー装置の出力が 230mW のときの電流値である。また、比較例として界面保護層なしとして同じ条件で信頼性試験を行った結果、図7の上側に示すように短時間で端面破壊が生じた。 30 40

【0033】

また、本第1実施形態において、上記界面保護層の厚さが 30\AA を越えると光を吸収してしまい半導体レーザー装置の特性が悪化する傾向にあるので、 30\AA 以下であれば、上記と同様な特性向上の効果が得られる。

【0034】

また、本第1実施形態において、上記ガイド層がAlGaAsからなることにより、発光再結合のおこる井戸層にはAlGaAsは隣接させないことで信頼性を確保しながら、キ 50

キャリアのオーバーフローはAlGaAsのコンダクションバンド（伝導帯）下端のエネルギー準位 E_c およびバレンスバンド（価電子帯）上端のエネルギー準位 E_v により十分に抑制する効果を得ることができる。通常高信頼性を得るためにAlフリーの半導体レーザ装置を作る場合、ガイド層、クラッド層までInGaPなどで全てAlフリーとする。し

かし、本第1実施形態では、発振波長780nm帯のInGaAsPからなる井戸層に対し、本第1実施形態では、発振波長780nm帯のInGaAsPからなる井戸層に対するコンダクションバンドのエネルギー差（ ΔE_c ）、バレンスバンドのエネルギー差（ ΔE_v ）がバランスよく得られるAl混晶比が0.2より大きいAlGaAsを、ガイド層として設けている。

【0035】

図9にガイド層のAl混晶比に対する特性温度（ T_0 ）の関係を示すグラフを示す。図9に示すように、ガイド層のAl混晶比が0.2よりも大きいAlGaAsの場合に温度特性が向上していることが確認されており、十分高い信頼性を得ることができる。

【0036】

また、本第1実施形態において、上述の通りGaAs基板上的InGaAsPからなる圧縮歪井戸層が用いられているために発振しきい値電流が低減され、これにより特に780nm帯において信頼性が高く長寿命な高出力半導体レーザ装置が実現され、高信頼性の高出力半導体レーザ装置が得られる。また、上記圧縮歪量が3.5%以内であることにより、より好適に上記効果が得られる。ここでいう歪量とは、GaAs基板の格子定数を a_0 、井戸層の格子定数を a_1 とすると、

$(a_1 - a_0) / a_0$ で表される。この値が正であれば圧縮歪、負であれば引張り歪と呼ばれる。図8に井戸層の圧縮歪量の違いによる半導体レーザ装置の信頼性（70℃、230mW）を示すグラフを示しており、圧縮歪量が3.5%を越えると信頼性が悪化しているのが分かる。これは、圧縮歪量が大き過ぎて井戸層の結晶性が悪くなっているためと考えられる。

【0037】

また、本第1実施形態において、InGaAsPからなる引張り歪バリア層が用いられており、圧縮歪を有する井戸層に対してその歪量を補償しているのも、より安定した結晶をもつ歪量子井戸活性層を作製することができ、高信頼性の半導体レーザ装置を実現できる。また、上記引張り歪量が3.5%以内であることにより、より好適に上記効果が得られた。

【0038】

また、上記第1実施形態では、埋込リッジ構造としたが、これに限るものではない。リッジ構造、内部ストライプ構造、埋込ヘテロ構造など、あらゆる構造に対して同様の効果が得られる。また、本第1実施形態では、n型基板を用いたが、p型基板を用い、上記第1実施形態のn型、p型を入れ替えても、同様の効果は得られる。また、波長は780nmとしたが、これに限るものではない。760nmより大きく800nmより小さいいわゆる780nm帯であれば同様の効果が得られる。

【0039】

また、上記第1実施形態では、p-GaAsキャップ層119はおよそ2 μ mとしているが、およそ50 μ mと厚く積層してもよい。また、成長温度を750℃および680℃としているが、この温度に限るものではない。すなわち、成長中断界面にGaAsからなる界面保護層を設けることで、複数の異なる材料系で構成される層を含む半導体レーザ装置構造を結晶成長するときに、それぞれの材料ごとに良好な結晶が得られるように結晶成長温度を最適化し、その最適温度で結晶成長することができる。

【0040】

（第2実施形態）

本第2実施形態は、第1実施形態に記載されている半導体レーザ装置と同じ構造をもつが、結晶成長させるときに、一定温度にて成長させている。図1は本第2実施形態の半導体レーザ装置の図も兼ねる。

【0041】

本第2実施形態の半導体レーザ装置において、発振波長は780nmであり、図7に示す

ように、85℃、200mWパルスの信頼性試験において5000時間以上の安定な動作を確認した。

【0042】

本第2実施形態において、720℃にてすべての半導体層が成長されているので、第1実施形態とは異なり成長中断がない。すなわち、成長中断中に生じると考えられるAlGaAsの酸化や、また同じく成長中断中に生じると考えられるPの再蒸発が、成長中断そのものがないために抑えられると考えられる。さらに、異なる材料系からなる層の界面で温度が変わらないために界面での材料系の急峻性をより向上するために、GaAsによる界面保護層を設けることで、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザー装置を製造することができる。

10

【0043】

(第3実施形態)

図11は、本発明に係る半導体レーザー装置を用いた光ディスク装置の構造の一例を示したものである。これは光ディスク401にデータを書き込んだり、書き込まれたデータを再生するためのものであり、そのときに用いられる発光素子として、先に説明した本発明第1実施形態の半導体レーザー装置402を備えている。

【0044】

この光ディスク装置についてさらに詳しく説明する。書き込みのときは、半導体レーザー装置402から出射された信号光がコリメートレンズ403により平行光とされ、ビームスプリッタ404を透過してλ/4偏光板405で偏光状態が調節された後、対物レンズ406で集光され光ディスク401に照射される。読み出し時には、データ信号がのっていないレーザー光が書き込み時と同じ経路をたどって光ディスク401に照射される。このレーザー光がデータの記録された光ディスク401の表面で反射され、レーザー光照射用対物レンズ406、λ/4偏光板405を経た後、ビームスプリッタ404で反射されて90°角度を変えた後、再生光用対物レンズ407で集光され、信号検出用受光素子408に入射する。信号検出用受光素子408内で入射したレーザー光の強弱によって記録されたデータ信号が電気信号に変換され、信号光再生回路409において元の信号に再生される。

20

【0045】

本第3実施形態の光ディスク装置は、従来よりも高い光出力で動作する半導体レーザー装置を用いているため、ディスクの回転数を従来より高速化してもデータの読み書きが可能である。従って、特に書き込み時に問題となっていたディスクへのアクセス時間が従来の半導体レーザー装置を用いた装置よりも格段に短くなり、より快適に操作できる光ディスク装置を提供することができる。

30

【0046】

なお、ここでは本発明の半導体レーザー装置を記録再生型の光ディスク装置に適用した例について説明したが、同じ波長780nm帯を用いる光ディスク記録装置、光ディスク再生装置にも適用可能であることはいうまでもない。

【0047】

なお、本発明の半導体レーザー装置および光ディスク装置は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、例えば井戸層・バリア層の層厚や層数など、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

40

【0048】

【発明の効果】

以上より明らかなように、この発明の半導体レーザー装置によれば、GaAs基板上に、下ガイド層、InGaAsPからなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、上ガイド層が少なくとも積層されており、発振波長が760nmより大きく800nmより小さい半導体レーザー装置において、上記量子井戸活性層と上記上ガイド層との間または上記量子井戸活性層と上記下ガイド層との間の少なくとも一方に界面保護層が設けられていることにより、上記量子井戸活性層と上記上ガイド層あるいは上記下ガイド層もしくはその両方の界面が急峻になるとともに、結晶のエピタキシー成長が

50

良好になるため、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を実現することができる。

【0049】

また、本発明の半導体レーザ装置の製造方法によれば、GaAs基板上に、少なくともAlGaAsからなる下ガイド層、GaAsからなる下界面保護層、InGaAsPからなる一層または複数層の井戸層および複数のバリア層を有する量子井戸活性層、GaAsからなる上界面保護層、AlGaAsからなる上ガイド層を有する半導体レーザ装置の製造方法において、第1の成長温度にて上記下ガイド層およびGaAsからなる下界面保護層を結晶成長させる第1の工程と、上記第1の工程の後、成長を中断し第2の成長温度まで成長温度を下降させる第2の工程と、上記第2の工程の後、成長を再開して上記量子井戸活性層とGaAsからなる上界面保護層とを順次成長させる第3の工程と、上記第3の工程の後、成長を中断し成長温度をほぼ上記第1の成長温度まで上昇させる第4の工程と、上記第4の工程の後、成長を再開して上記界面保護層上に上記上ガイド層を成長させる第5の工程と、を含むことにより、上記下ガイド層のAlGaAsの酸化を上記下界面保護層が防いで、上記下ガイド層よりも成長温度の低い上記量子井戸活性層を成長させることができ、また、上記量子井戸活性層内の昇温によるPの再蒸発を上記上界面保護層が防いで、上記上ガイド層を成長させることができ、高出力駆動時の信頼性が高く長寿命な半導体レーザ装置を製造することができる。

【0050】

また、本発明の光ディスク装置によれば、高い光出力で動作する上記半導体レーザ装置を用いることによって、従来よりも半導体レーザ装置であるため、ディスクの回転数を従来より高速化してもデータの読み書きが可能である。従って、特に書き込み時に問題となっていたディスクへのアクセス時間が従来の半導体レーザ装置を用いた装置よりも格段に短くなり、より快適に操作できる光ディスク装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係る半導体レーザ装置のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

【図2】上記半導体レーザ装置の第1回結晶成長マスクプロセス終了後のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

【図3】上記半導体レーザ装置のメサストライプ形成エッチングプロセス終了後のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

【図4】上記半導体レーザ装置の電流ブロック層埋め込み結晶成長プロセス終了後のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

【図5】上記半導体レーザ装置のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

【図6】従来および本発明に係る半導体レーザ装置の光出力ー電流特性を示すグラフである。

【図7】界面保護層の有無による半導体レーザ装置の信頼性の違いを示すグラフである。

【図8】井戸層の圧縮歪量の違いによる半導体レーザ装置の信頼性を示すグラフである。

【図9】上記半導体レーザ装置のガイド層のAl混晶比に対する温度特性の関係を示すグラフである。

【図10】本発明の第1実施形態に係る半導体レーザ装置の成長温度プロファイル図である。

【図11】本発明の第3実施形態に係る光ディスク装置の概略図である。

【図12】従来の半導体レーザ装置のストライプ方向に対して垂直な面の断面図である。

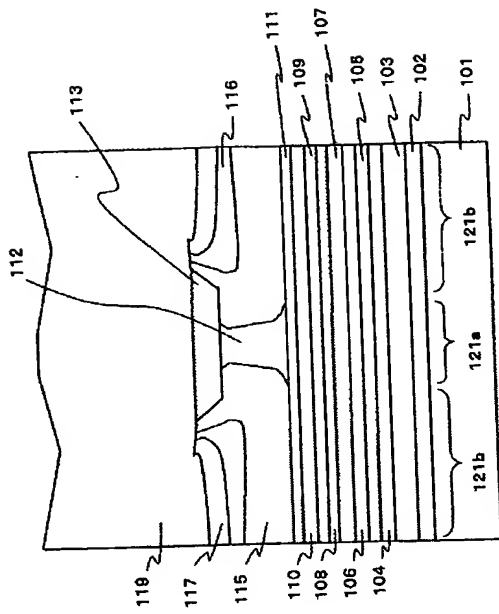
【符号の説明】

- 101 基板
- 102 バッファ層
- 103 下クラッド層
- 104 下クラッド層

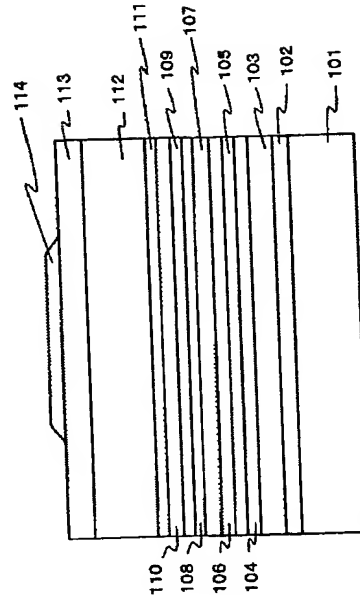
105	下ガイド層	
106	下界面保護層	
107	多重歪量子井戸活性層	
108	上界面保護層	
109	上ガイド層	
110	上クラッド層	
111	エッチングストップ層	
112	上クラッド層	
113	キャップ層	
114	レジストマスク	10
115	電流ブロック層	
116	電流ブロック層	
117	平坦化層	
118	レジストマスク	
119	キャップ層	
121a	メサストライプ部	
121b	メサストライプ部両側	
401	光ディスク	
402	半導体レーザ装置	
403	コリメートレンズ	20
404	ビームスプリッタ	
405	偏光板	
406	レーザ光照射用対物レンズ	
407	再生光用対物レンズ	
408	信号検出用受光素子	
409	信号光再生回路	
501	基板	
502	バッファ層	
503	下クラッド層	
504	下ガイド層	30
505	多重歪量子井戸活性層	
506	上ガイド層	
507	第1上クラッド層	
508	エッチストップ層	
509	第2上クラッド層	
510	キャップ層	
511	電流ブロック層	
512	電流ブロック層	
513	平坦化層	
514	コンタクト層	40

(12)

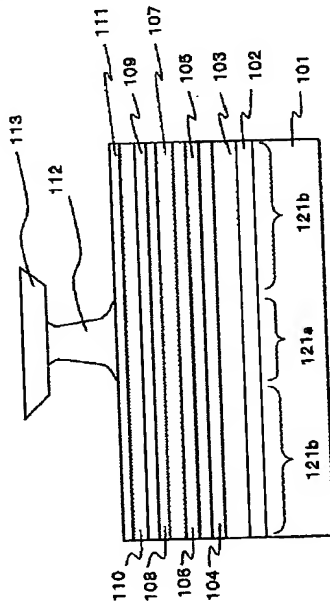
【図 1】



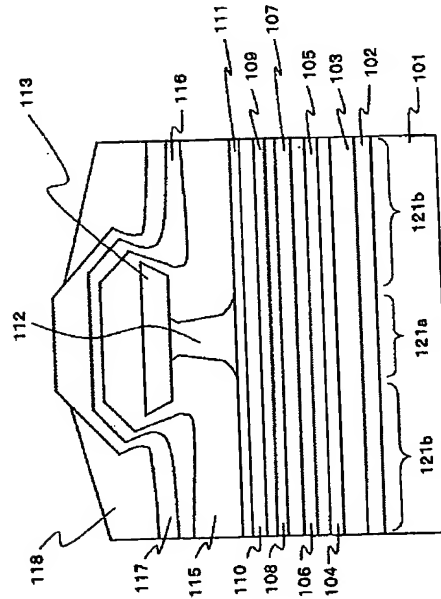
【図 2】



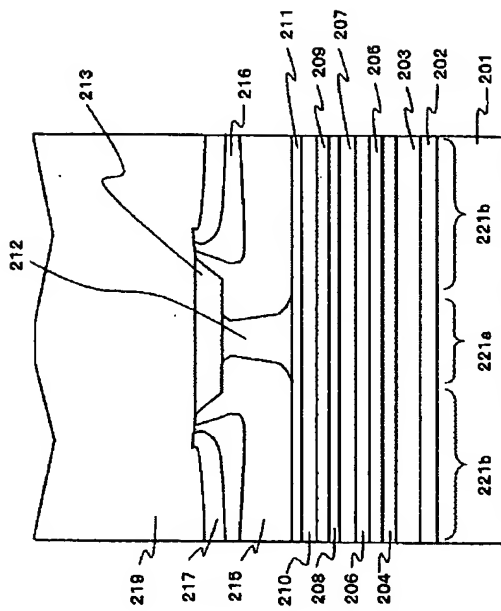
【図 3】



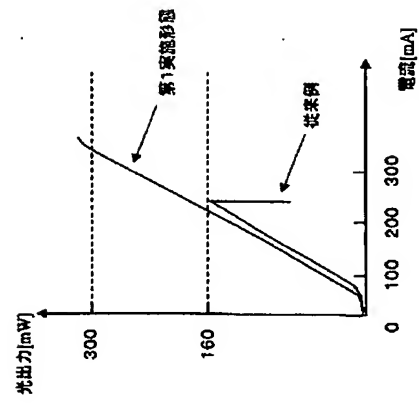
【図 4】



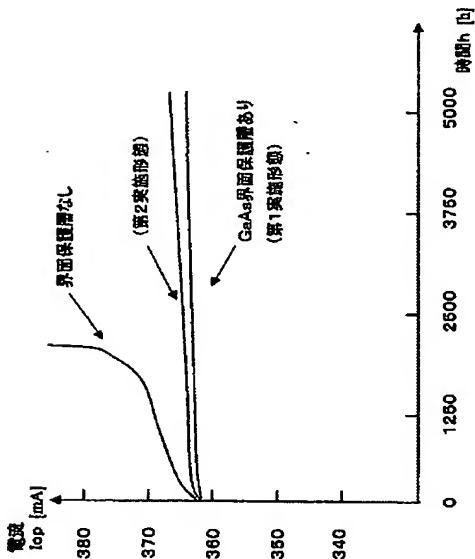
【図 5】



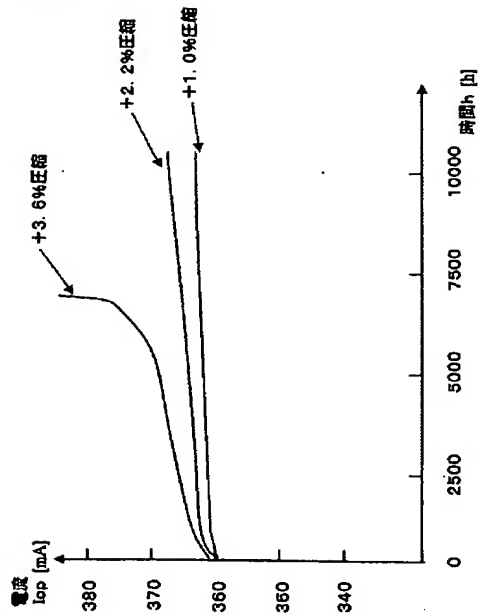
【図 6】



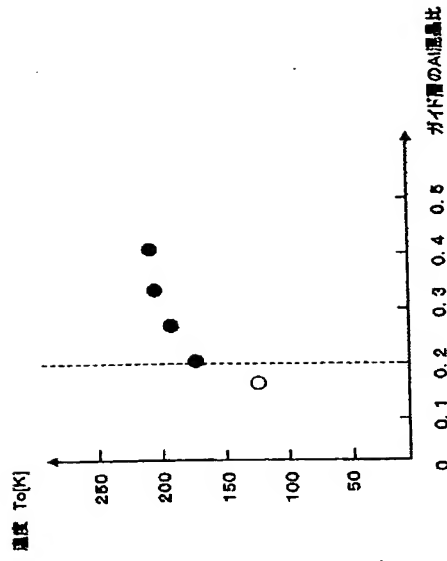
【図 7】



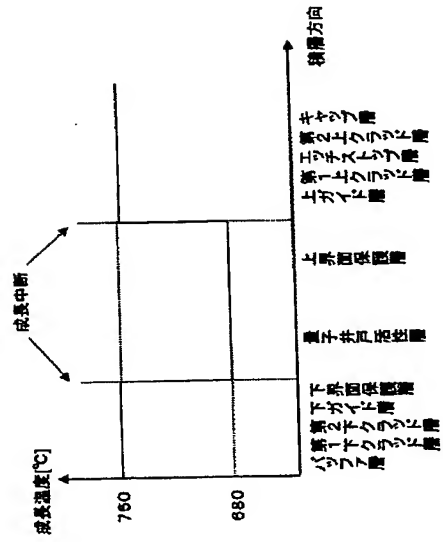
【図 8】



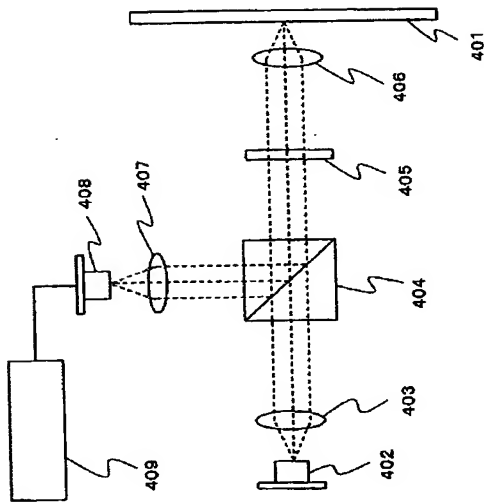
【図 9】



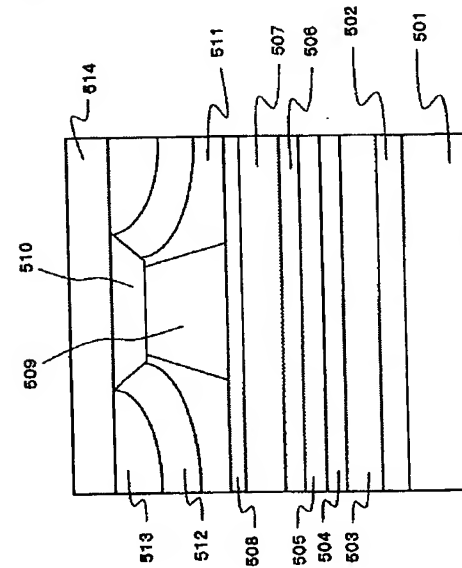
【図 10】



【図 11】



【図 12】



フロントページの続き

(72)発明者 山本 圭

大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号 シャープ株式会社内

Fターム(参考) 5D789 AA33 AA42 BA01 FA05 FA17

SF045 AA04 AB10 AD10 AD11 AF04 BB16 CA12 CB00

SF073 AA07 AA45 AA74 AA89 BA05 CA13 CB02 CB19 DA05 DA22

EA24 EA28

THIS PAGE BLANK (USPTO)